CEPHEUS Mark

Technische Daten | Specifications

Laser-Typ	Nd: YVO_4; λ =1064 nm	laser type
Max. mittlere Leistung	@ 1064nm; 500 kHz: > 12W, > 16W	max. average power
Pulsdauer	< 15ps	pulse duration
Frequenzbereich	20 kHz – 500 kHz; single shot	frequency range
Strahlqualität	TEM_{00} (M^2 < 1,5)	beam quality
Kühlung	luftgekühlt | air-cooled	cooling
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C	ambient temperature
Anwendungs-Software	Software PHOTONmark	application software
Elektrischer Anschluss	90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz	power supply
Leistungsaufnahme	max. 1 kW	power consumption
Kabellängen; Biegeradius	2 m; > 0,2 m	umbilical lengths; bending radius
Linse (Beschriftungsfeld)	f = 160 mm (100 x 100 mm^2) *1	lens (marking field size)
Abmessungen (L x B x H)		dimensions (L x W x H)
▪ Lasereinheit	763 x 420 x 340mm^3, ca. 70kg	▪ laser unit
▪ Lasersteuerung	523 x 440 x 177mm^3, 19", 26kg	▪ laser control unit
▪ Markiersteuerung	471 x 482 x 133mm^3, 19", 12,4kg	▪ marking control unit

*1 weitere Linsen bzw. Feldgrößen auf Anfrage | additional lenses and field sizes on inquiry

CEPHEUS Marker:
Strahlquelle CEPHEUS mit BDM,
Ablenkeinheit und LCC Modul

CEPHEUS Mark:
laser source CEPHEUS with BDM,
beam scanning device and LCC module

Version USA 1.1 | version USA 1.1
Änderungen und Irrtümer vorbehalten | amendments and errors may occur